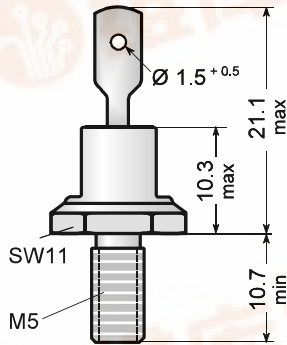


Silicon-Power Rectifiers

Silizium-Leistungs-Gleichrichter



Dimensions / Maße in mm

Nominal current – Nennstrom 12 A

Repetitive peak reverse voltage 50...1000 V
Periodische Spitzensperrspannung

Metal case – Metallgehäuse DO-4

Weight approx. – Gewicht ca. 5.5 g

Recommended mounting torque 18 ± 10% lb.in.
Empfohlenes Anzugsdrehmoment 2 ± 10% Nm

Standard: Cathode to stud / am Gewinde

Index R: Anode to stud / am Gewinde (e.g. 1N 1199 A/R)

Maximum ratings

Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
1N 1199 A = PBY 271	50	60
1N 1200 A = PBY 272	100	120
1N 1202 A = PBY 273	200	240
1N 1204 A = PBY 274	400	480
1N 1206 A = PBY 275	600	720
1N 3671 = PBY 276	800	1000
1N 3673 = PBY 277	1000	1200

Max. average forward rectified current, R-load $T_C = 100^\circ\text{C}$ I_{FAV} 12 A ¹⁾
Dauergrenzstrom in Einwertschaltung mit R-Last

Repetitive peak forward current $f > 15\text{ Hz}$ I_{FRM} 40 A ¹⁾
Periodischer Spitzenstrom

Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave $T_A = 25^\circ\text{C}$ I_{FSM} 220 A
Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen

Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave $T_A = 25^\circ\text{C}$ I_{FSM} 240 A
Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwellen

Rating for fusing – Grenzlastintegral, $t < 10\text{ ms}$ $T_A = 25^\circ\text{C}$ i^2t 240 A²s

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur

T_j – 65...+175°C
 T_s – 65...+175°C

Characteristics

Kennwerte

Forward voltage – Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 30\text{ A}$	V_F	< 1.5 V
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	< 100 μA
Thermal resistance junction to stud Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse			R_{thC}	< 2 K/W

